Ausarbeitung Übung 5

Studienarbeit von Dominik Schiller, Constanze Kramer, Simon Arnold & Tobias Lingenberg Datum: 16. Dezember 2020

Darmstadt



Ausarbeitung Übung 5

Studienarbeit von Dominik Schiller, Constanze Kramer, Simon Arnold & Tobias Lingenberg

Datum: 16. Dezember 2020

Darmstadt

Inhaltsverzeichnis

1	Bear	rbeitung der Aufgaben	2
	1.1	Geschichteter Plattenkondensator	2
	1.2	Aufgabe 5.3	5
2	Anha	anα	8

1 Bearbeitung der Aufgaben

1.1 Geschichteter Plattenkondensator

Um numerisch die Kapazität eines Plattenkondensators mit quer geschichteten Dielektrika, die eine linear steigende relative Permittivität aufweisen, zu bestimmen, kann man den linearen Verlauf über mehrere Schichten mit jeweils konstanter Permittivität approximieren. Wie bei numerischen Verfahren üblich wird die Approximation besser, je dünner die einzelnen Schichten gewählt werden.

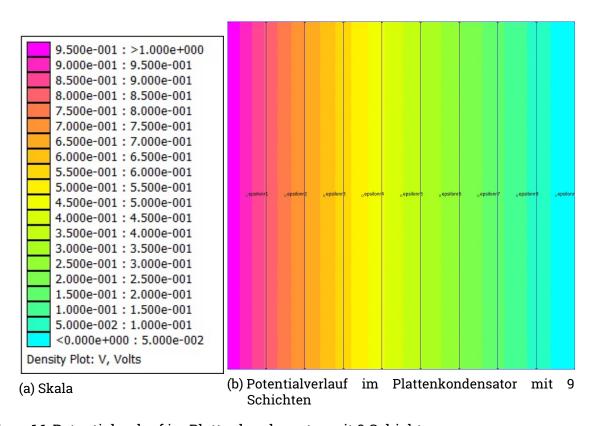


Abbildung 1.1: Potentialverlauf im Plattenkondensator mit 9 Schichten

Die Funktion femmcapacity.m bekommt als Parameter den Abstand h zwischen den beiden Platten des Kondensators, die Kantenlänge a der quadratischen Platten, $\varepsilon_{\rm r,1}, \varepsilon_{\rm r,2}$ und die Anzahl N an Schichten übergeben. Mit Hilfe dieser Parameter wird daraus ein Plot für den Potentialverlauf im Kondensator erzeugt und die Kapazität der Anordnung berechnet. Die relative Permittivität variiert hierbei linear zwischen $\varepsilon_{\rm r,1}$ am linken

Rand und $\varepsilon_{r,2}$ am rechten Rand. Die zugehörigen Werte der relativen Permittivitäten der einzelnen Schichten N_i lassen sich mit

$$\varepsilon_{\rm r,i} = \varepsilon_{\rm r,1} + \frac{i(\varepsilon_{\rm r,2} - \varepsilon_{\rm r,1})}{N-1}$$

berechnen. Im Folgenden wird der Abstand zwischen den Platten und die Kantenlänge mit $30~\mathrm{cm}$ angenommen. Wählt man 9 Schichten, $\varepsilon_{\mathrm{r},1}=1$ und $\varepsilon_{\mathrm{r},2}=2$ erhält man den in Abbildung 1.1b zu sehenden Potentialverlauf und eine Kapazität $C_1=3{,}793~\mathrm{pF}$.

Wiederholt man die Simulation für N=1,2,3,...,20 Schichten und lässt sich in einem Konvergenz-Plot (Abbildung 1.2) die Kapazität in Abhängigkeit der Schichtanzahl anzeigen, wird deutlich, dass schon nach N=3 Schichten die Kapazität annähernd exakt bestimmt wird und weitere Verfeinerungen nur noch marginale Verbesserungen der Approximation erzielen.

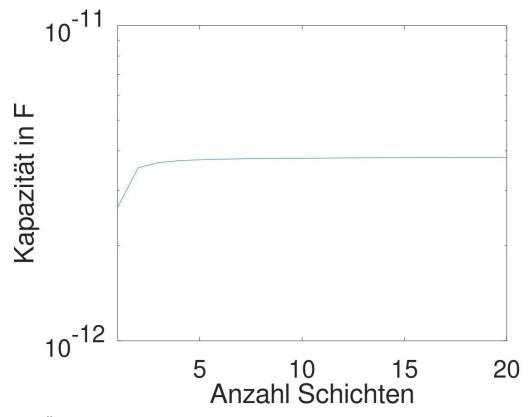


Abbildung 1.2: Änderung der Kapazität mit steigender Anzahl an Schichten im Plattenkondensator

Die Option 'Vector Plot' in FEMM ist nützlich, um den Verlauf des elektrischen Feldes besser darzustellen. Die Richtung der Pfeile zeigt an in welche Richtung das Feld an dieser Stelle zeigt und die Länge der Pfeile deutet die Stärke an dieser Stelle an.

In Abbildung 1.3b sieht man den Plot für den homogenen Plattenkondensator und in Abbildung 1.3c für den geschichteten Fall. Vergleicht man beide Abbildungen fällt auf, dass das elektrische Feld im homogenen Plattenkondensator homogen verteilt ist. Beim geschichteten Plattenkondensator hingegen ist das elektrische Feld deutlich stärker auf der Seite mit der geringeren relativen Permittivität und nimmt immer weiter ab, je höher die relative Permittivität ist.

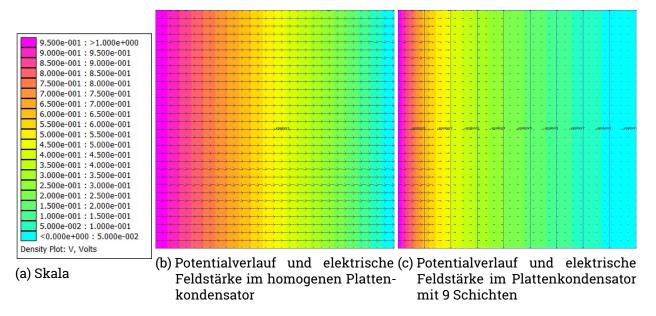


Abbildung 1.3: Potentialverlauf und elektrische Feldstärke im homogenen und im geschichteten Plattenkondensator

Bestimmt man die Kapazität für $\varepsilon_{\rm r,1}=1$ und $\varepsilon_{\rm r,2}=10$ und N=9 und vergleicht diese mit der vorher bestimmten Kapazität C_1 stellt man fest, dass durch eine höhere relative Permittivität auch die Kapazität von $3,793\,{\rm pF}$ auf $8,916\,{\rm pF}$ steigt.

1.2 Aufgabe 5.3

Wie in den vorherigen Aufgaben und Ausarbeitungen gezeigt, lassen sich mit Hilfe von FEMM sehr gute Simulationen von Plattenkondensatoren erzeugen. Aber auch Kugelkondensatoren lassen sich mit FEMM simulieren und berechnen.

Die Methode spherecapacity.m, die im Anhang zu finden ist, nimmt die zwei Parameter R_1 , der den Innenradius beschreibt und ε_r , das die relative Permittivität des Dielektrikums darstellt, entgegen. Aus der Aufgabenstellung geht hervor, dass für den zweiten zur Berechnung der Kapazität benötigten Parameter $R_2 = R_1 + 7 \, \mathrm{cm}$ gilt. R_2 ist der Außenradius des Kugelkondensators. Optional könnte man die Methode auch so schreiben, dass R_2 übergeben werden kann.

Im Vergleich zu den bisherigen Simulationen in FEMM haben wir nun kein planares Problem mehr, sondern ein achsensymmetrisches. In der Problemdefinition (Zeile 6) wird deshalb ein 'axi' übergeben. Damit wird bestimmt, dass sich die erzeugte Fläche in Abbildung 1.4 nicht in die Tiefe entwickelt, sondern um die z-Achse gedreht wird. Dadurch erhält man eine 3-Dimensionale Kugel, die FEMM zwar nicht darstellen, aber berechnen kann.

Zunächst werden zwei Halbkreise erzeugt (Zeile 12-26), zwischen diesen beiden Halbkreisen liegt eine Spannungsdifferenz von 1 V an. Des Weiteren werden zwei Blocklabel erstellt (Zeile 28 und 31), das erste Label liegt zwischen den beiden Halbkreisen und beinhalten die Informationen über die relative Permittivität des Dielektrikums. Mit dem zweiten Label wird sichergestellt, dass nur die von den beiden Halbkreisen und deren Verbindungslinien eingeschlossene Fläche bei der Berechnung berücksichtigt wird. Hierzu wird dem Label die Property '<No Mesh>' übergeben. Schließlich werden die Verbindungslinien zwischen den Halbkreisen erstellt(Zeile 38 und 39), um eine abgeschlossene Fläche zu erzeugen.

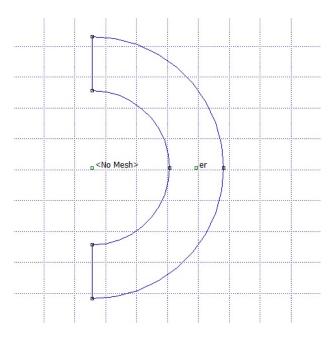


Abbildung 1.4: Ein mit Hilfe der Routine spherecapacity.
m erzeugter Kugelkondensator mit $R_1=7\,\mathrm{cm}$

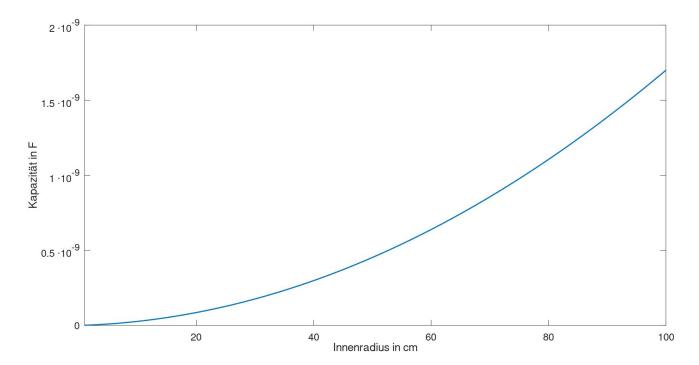


Abbildung 1.5: Verlauf der Kapazität mit steigendem Radius R_1 und $R_2=R_1+7\,\mathrm{cm}$

Mit

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1} \tag{1}$$

lässt sich die Kapazität eines homogenen Kugelkondensators berechnen. Um den Einfluss der Radien auf die Kapazität zu untersuchen, wurden der Methode spherecapacity.m 100 verschiedene Radien $R_1 \in \mathbb{N}, R_1 \in [1,100]$, mit der Einheit cm übergeben. Für den Radius R_2 gilt weiterhin

$$R_2 = R_1 + 7 \,\mathrm{cm}.$$
 (2)

Die berechneten Kapazitätswerte sind in Abbildung 1.5 graphisch dargestellt. Die Formel

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{(R_1 + 7\,\mathrm{cm})R_1}{R_1 + 7\,\mathrm{cm} - R_1} \tag{3}$$

ergibt sich indem man (2) in (1) einsetzt. Durch weiteres vereinfachen folgt, dass die Kapazität

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r \frac{R_1^2 + 7\,\mathrm{cm}}{7\,\mathrm{cm}} \tag{4}$$

quadratisch von R_1 abhängt, dies erklärt den quadratischen Verlauf der Kapazität (Abbildung 1.4) des Kugelkondensators mit steigendem Innenradius.

Unter der Voraussetzung, dass $(R_2+R_1)=15~\mathrm{cm}$ gilt, beträgt der Innenradius $R_1=4~\mathrm{cm}$ und der Außenradius $R_2=11~\mathrm{cm}$. Analytisch lässt sich mit (1) eine Kapazität $C_{\mathrm{ana}}=6{,}994~\mathrm{pF}$ berechnen, FEMM berechnet eine Kapazität $C_{\mathrm{num}}=6{,}986~\mathrm{pF}$.

Der relative Fehler

$$\operatorname{err} := \frac{|C_{\operatorname{ana}} - C_{\operatorname{num}}|}{|C_{\operatorname{ana}}|} \tag{5}$$

ergibt sich mit den vorher berechneten Werten $C_{\rm ana}$ und $C_{\rm num}$ zu $1.1\cdot 10^{-3}$, liegt also im niedrigen Promillebereich. Die durch FEMM berechnete Annäherung ist sehr exakt.

2 Anhang

```
function C = femmcapacity (h, a, e1, e2, N)
2
     openfemm;
3
     newdocument(1);
     ei_probdef('centimeters','planar',1.E-8,a,30);
     ei_addmaterial('Vakuum',1,1,0);
     %ei_addmaterial('epsilonr1',e1,e1,0);
%ei_addmaterial('epsilonr2',e2,e2,0);
     if (N==1)
       ei_addmaterial(strcat('epsilonr',num2str(1)),e1,e1,0);
     else
11
       for i=0:N-1
          ei addmaterial (strcat ('epsilonr', num2str(i+1)), e1+i*(e2-e1)/(N-1), e1+i*(e2-e1)/(N-1), 0)
       endfor
14
     endif
15
16
     %ei_addboundprop('Randbedingung','Vs',0,0,0,0);
17
     ei_addconductorprop('Linker Rand',1,0,1);
18
     ei_addconductorprop('Rechter Rand',0,0,1);
19
2.0
     %Randpunkte fuer den Kondensator erstellen
21
     ei_drawrectangle(0,0,h,a);
22
23
     %Linken und rechten Rand setzen
24
25
     ei selectsegment (0,a/2);
     ei_setsegmentprop('<None>',0,1,0,0,'Linker Rand');
26
     ei_clearselected;
     ei_selectsegment(h,a/2);
     ei_setsegmentprop('<None>',0,1,0,0,'Rechter Rand');
     ei_clearselected;
30
31
     %Oberen und unteren Rand setzen
32
     ei selectsegment (h/2,0);
33
     ei_selectsegment(h/2,a);
34
     ei_setsegmentprop('<None>',0,1,0,0,'<None>');
35
     ei clearselected;
36
37
38
     ei addnode(h/N,0);
39
     ei addnode(h/N,a);
     ei_addsegment(h/N,0,h/N,a);
40
41
     ei_selectsegment(h/N,a/2);
42
     ei_copytranslate2(h/N,0,N-2,1);
43
     ei_clearselected;
44
     ei_addblocklabel(h/(2*N),a/2);
45
     ei_selectlabel(h/(2*N),a/2);
```

```
47
     ei copytranslate2(h/N,0,N-1,2);
     ei_clearselected;
48
49
     for i = 1:2:2*N
50
      ei_selectlabel(i*h/(2*N),a/2);
51
      ei setblockprop(strcat('epsilonr', num2str(1+(i-1)/2)),1,0,0);
      ei clearselected;
53
     endfor
54
55
     %Speichere die Datei ab
56
     ei saveas ('Aufgabe5 2.FEE');
57
58
     %Lade die gepeicherte Datei und erzeuge Simulation
59
     ei analyze(0);
60
     ei_loadsolution;
61
62
     %Liegenden Vektor erstellen, Ladung / Spannung ergibt Kapazit\"at C
     G = [0,0];
     G = eo getconductorproperties ('Linker Rand');
65
     C = G(1,2)/G(1,1);
   endfunction
```

data/femmcapacity.m

```
function C = spherecapacity (R1, er)
     R2 = R1 + 7;
     openfemm;
     newdocument(1);
     ei_probdef('centimeters','axi',1.E-8,0,30);
     ei_addmaterial('er',er,er,0);
     %Conductor Props erstellen
8
     ei_addconductorprop('Rand1',1,0,1);
9
     ei_addconductorprop('Rand2',0,0,1);
12
     %Draw first arcs
13
     ei_drawarc(0,-R1,R1,0,90,90);
     ei_drawarc(0,-R2,R2,0,90,90);
     %Set segment property and rotate arc once
     ei_selectarcsegment(0,-R1);
     ei_setarcsegmentprop(10, '<None>',0,0, 'Rand1');
18
     ei_copyrotate2(0,0,90,1,3);
19
     ei_clearselected;
20
21
     %Set segment property and rotate arc once
22
     ei selectarcsegment (0,-R2);
23
     ei_setarcsegmentprop(10, '<None>',0,0, 'Rand2');
     ei_copyrotate2(0,0,90,1,3);
25
     ei_clearselected;
26
27
     ei_addblocklabel(R2-(R2-R1)/2,0);
2.8
     ei_selectlabel(R2-(R2-R1)/2,0);
29
     ei_setblockprop('er',1,0,0);
30
     ei_clearselected;
31
32
     ei addblocklabel(0,0);
33
```

```
ei selectlabel(0,0);
34
     ei_setblockprop('<No Mesh>',1,0,0);
35
     ei_clearselected;
36
37
     ei_addsegment(0,R2,0,R1);
38
     ei addsegment(0, -R2, 0, -R1);
39
40
41
     %Speichere die Datei ab
42
     ei_saveas('Aufgabe5_3.FEE');
43
44
     %Lade die gepeicherte Datei und erzeuge Simulation
45
     ei_analyze(0);
46
     ei loadsolution;
47
48
     %Liegenden Vektor erstellen , Ladung / Spannung ergibt Kapazit\"at C
49
     G = [0,0];
     G = eo_getconductorproperties('Rand1');
     C = G(1,2)/G(1,1);
52
53
   endfunction
```

data/spherecapacity.m

```
%C = zeros(1,20);

%for i=1:20

% C(1,i)= femmcapacity(30, 30, 1, 2, i);

%endfor

N = 1:1:20;

semilogy(N,C, 'linewidth',3);

xlabel('Anzahl Schichten', 'fontsize',26);
ylabel('Kapazitaet in F', 'fontsize',26);
set(gca, 'Fontsize',26);
axis([1 20]);
```

data/Ag5_2b.m

```
R = 1:1:100;
  \%C = zeros(1,100);
   ##for i = 1 : 100
   ## C(1,i) = spherecapacity(R(1,i),1);
   ##endfor
   plot(R,C,'linewidth',3);
   axis([1 100]);
   xlabel('Innenradius in cm', 'Fontsize',26);
9
   ylabel('Kapazitaet in F', 'Fontsize',26);
10
   set(gca, 'Fontsize',26);
11
   ##Yticks = get(gca, 'Ytick');
12
   ##YTickLabels = cellstr(num2str(round(log10(Yticks(:))), '10^%d'));
13
   ##set(gca,'YTickLabel', YTickLabels);
14
15
   ytick=get(gca, 'ytick');
16
   yticklab = [
```

data/Ag5_3b.m

Abbildungsverzeichnis

1.1	Potentialverlauf im Plattenkondensator mit 9 Schichten	2
1.2	Änderung der Kapazität mit steigender Anzahl an Schichten im Plattenkondensator	3
1.3	Potentialverlauf und elektrische Feldstärke im homogenen und im geschichteten Plattenkon-	
	densator	4
1.4	Ein mit Hilfe der Routine spherecapacity. ${\tt m}$ erzeugter Kugelkondensator mit $R_1=7{\rm cm}$.	5
1.5	Verlauf der Kapazität mit steigendem Radius R_1 und $R_2 = R_1 + 7 \mathrm{cm}$	6